09

# Высокочастотные дифракционные Мо/Ве-решетки с малым углом блеска–исследование эффективности

© Л.И. Горай,<sup>1,2,3,4</sup> А.С. Дашков,<sup>1,2</sup> Н.А. Костромин,<sup>1,2</sup> Д.В. Мохов,<sup>2</sup> Т.Н. Березовская,<sup>2</sup> К.Ю. Шубина,<sup>2</sup> Е.В. Пирогов,<sup>2</sup> В.А. Шаров,<sup>5</sup> С.А. Гарахин,<sup>6</sup> М.В. Зорина,<sup>6</sup> Р.С. Плешков,<sup>6</sup> Н.И. Чхало,<sup>6</sup> А.Д. Буравлев<sup>1,3,4,5</sup>

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 197022 Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова РАН,

194021 Санкт-Петербург, Россия

<sup>3</sup> Институт аналитического приборостроения РАН,

198095 Санкт-Петербург, Россия

<sup>4</sup> Университет при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС,

199226 Санкт-Петербург, Россия

<sup>5</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

194021 Санкт-Петербург, Россия

<sup>6</sup> Институт физики микроструктур РАН,

603087 Афонино, Кстовский р-он, Нижегородская обл., Россия e-mail: lig@pcgrate.com

Поступило в Редакцию 17 апреля 2024 г. В окончательной редакции 17 апреля 2024 г. Принято к публикации 17 апреля 2024 г.

Представлены результаты исследований дифракционной эффективности решеток с блеском, выполненные путем моделирования в компьютерной программе PCGrate<sup>TM</sup> с использованием полученных с помощью атомно-силовой микроскопии профилей штрихов и измерений на лабораторном рефлектометре с высокоразрешающим спектрометром Черни-Тёрнера. Высокочастотные дифракционные решетки с плотностью 2500 mm<sup>-1</sup> и малым углом наклона отражающей грани были изготовлены на пластинах Si(111)1.8° с использованием электронно-лучевой литографии и анизотропного жидкостного травления. Решетка с углом блеска  $\sim 1.7^{\circ}$ , покрытая 40 бислоями Мо/Ве, продемонстрировала в классической схеме абсолютную дифракционную эффективность минус второго порядка  $\sim 38\%$  при угле падения 3° неполяризованного излучения с длиной волны 11.3 nm. С учетом измеренного коэффициента отражения многослойного покрытия  $\sim 0.6$  максимальная относительная (решеточная) эффективность составила  $\sim 63\%$ .

Ключевые слова: дифракционная Si-решетка с блеском, треугольный профиль штриха, малый угол блеска, многослойное Мо/Ве-покрытие, моделирование дифракционной эффективности, граничные интегральные уравнения, случайная шероховатость, атомно-силовая микроскопия, метод Монте-Карло, экстремальный ультрафиолет.

DOI: 10.61011/JTF.2024.07.58349.124-24

## Введение

Отражательные рентгеновские дифракционные решетки с треугольным профилем штриха (с "блеском") применяются в спектроскопии неупругого резонансного рентгеновского рассеяния, проекционной литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (ЭУФ) и за его пределами, в приборах космических миссий, на рабочих станциях рентгеновских лазеров на свободных электронах (РЛСЭ) и источников синхротронного излучения (СИ) четвертого поколения. Достижение высокой абсолютной дифракционной эффективности  $\eta$  (т.е. полученной с учетом коэффициента отражения материала покрытия) высокочастотных рентгеновских решеток с блеском, особенно работающих в коротковолновой части мягкого рентгеновского (MP) диапазона ("tender Xray"), возможно при наличии двух условий: (1) малого угла блеска *а*; (2) многослойного покрытия — для увеличения  $\eta$  и/или критического угла в классической схеме дифракции [1,2]. Глубина штрихов подобных высокочастотных многослойных решеток с малым углом блеска (ВМРМБ) должна составлять от нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров, и их профиль не должен меняться после нанесения многослойного покрытия.

В [3] анизотропным травлением была изготовлена Mo/Si ВМРМБ 5250 mm<sup>-1</sup> с  $\alpha = 2^{\circ}$  и ее измеренная абсолютная дифракционная эффективность составила в n = -1 порядке  $\eta(-1) = 40\%$  на длине волны  $\lambda = 13.3$  nm. В [4] аналогично была изготовлена W/B<sub>4</sub>C ВМРМБ 2500 mm<sup>-1</sup> с  $\alpha = 1.75^{\circ}$ , у которой удалось получить  $\eta(-2) = 13.5\%$  на  $\lambda = 1.77$  nm. В [5] для Cr/C-решетки 2400 mm<sup>-1</sup> с  $\alpha = 1^{\circ}$  была получена  $\eta(-1) = 60\%$  на  $\lambda = 0.4$  nm, а также и на  $\lambda = 0.3$  nm.

Необходимость совершенствования многослойных зеркал на основе Ве для продвижения ЭУФ литографии

следующего поколения была сформулирована сравнительно недавно [6], но всего за одну декаду удалось достичь высоких результатов в плане разработки, изготовления и характеризации Мо/Ве и других бериллийсодержащих многослойных зеркал не только для целей литографии, но и для задач космоса, рентгеновской микроскопии и др. [7-9]. Недавно нами впервые были изготовлены и исследованы многослойные Мо/Ве-решетки с блеском [10]. Частота решеток составила  $2500 \text{ mm}^{-1}$  и они имели относительно большой угол блеска  $\alpha \sim 3.9^{\circ}$ . В настоящей работе теоретико-экспериментальными методами определена η многослойных Мо/Ве ВМРМБ  $2500\,\mathrm{mm^{-1}}$  с  $\alpha \sim 1.8^\circ$ , предназначенных для работы в ЭУФ и изготовленных с помощью электронно-лучевой литографии, жидкостного анизотропного травления пластин Si и магнетронного напыления многослойного покрытия [11].

# 1. Методы исследования абсолютной дифракционной эффективности

Изготовленные Мо/Ве ВМРМБ предназначены работы в классической оптической схеме лля при около-нормальном падении  $(\theta \sim 0 - 10^\circ)$ излучения с  $\lambda = 11.3$  nm. Абсолютная дифракционная эффективность определялась в настоящей работе путем компьютерного моделирования с использованием реалистичных (измеренных с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ)) профилей штрихов и случайной шероховатости и взятых из [12] показателей преломления, а также с помощью прямых измерений абсолютной лифракционной эффективности на лабораторном ЭУФ рефлектометре в неполяризованном излучении. Технология изготовления исследуемых в настоящей работе дифракционных решеток, а также методы характеризации их морфологии (формы штрихов, толщины слоев, межслойной шероховатости/диффузности интерфейсов) представлены в отдельной статье [13].

#### 1.1. Дизайн решетки

Блеск решетки можно охарактеризовать с помощью простой геометрической модели — согласно уравнению решетки для классической (плоскостной) дифракции[14]:

$$\sin \theta_n - \sin \theta = n \frac{\lambda}{d}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$
 (1)

где n — порядок дифракции,  $n \in Z$ ,  $\theta$  и  $\theta_n$  — углы падения и дифракции соответственно, отсчитываемые от нормали (знаки углов выбираются по Картезианскому соглашению).

Если зеркальная волна, отраженная от грани штриха решетки, совпадает по направлению с направлением распространения *n*-го порядка дифракции, тогда

$$2\alpha = \xi_{\rm dif} - \xi_{\rm inc},\tag{2}$$

Журнал технической физики, 2024, том 94, вып. 7

где  $\xi_{inc} = 90^{\circ} - |\theta|$ ,  $\xi_{dif} = 90^{\circ} - |\theta_n|$ . Условие (2), характеризующее усиление определенного порядка дифракции, называется блеском (резонансом) решетки. Он явно не зависит ни от длины волны, ни от периода решетки и определяет связь угла блеска отражающей грани с углами падения и дифракции излучения. Это весьма общее геометрическое свойство теории рассеяния, которое характерно не только для решеток, но и для квазипериодических рассеивателей, типа самоорганизующихся островков (квантовых точек) с четко выраженными кристаллические гранями, а также случайных шероховатостей с треугольной формой профиля рассеивателей.

Асимптотическая теория дифракции предсказывает достижение 100% относительной (решеточной) дифракционной эффективности (т. е. полученной с учетом идеальной проводимости материала решетки) для порядка дифракции n на длине волны блеска  $\lambda_{blaze}$  в ТМ поляризации падающего излучения в случае треугольного профиля штриха с прямым углом при вершине при условии [15]:

$$|n|\lambda_{\text{blaze}} = 2d\sin\alpha. \tag{3}$$

Для брэгтовской моды с номером k период многослойного покрытия  $\Lambda$  определяется из условия Брэгга-Вульфа:

$$2\Lambda\cos\theta = k\lambda. \tag{4}$$

Отсюда требуемый  $\Lambda$  для ВМРМБ может быть легко оценен с использованием (1) для любого дифракционного порядка и угла блеска [2]:

$$\Lambda = d\sin\alpha/(|n|k). \tag{5}$$

Из (5) в соответствии с предсказаниями скалярной теории дифракции решетка с d = 400 nm,  $\alpha \approx 1.65^{\circ}$ и блеском для n = -2 должна иметь многослойное покрытие с  $\Lambda = 5.7$  nm при работе в первом брэгговском порядке. Для высокочастотных, даже неглубоких, решеток эта оценка является приблизительной [2,16], и ее необходимо уточнять прямыми численными расчетами с использованием электромагнитной теории дифракции и реалистичного профиля штрихов, что будет представлено далее. С учетом этого замечания от точности выполнения (5) и учета влияния угла антиблеска (поглощения ВМРМБ) зависит величина максимума абсолютной дифракционной эффективности, которая может быть достигнута на практике [17].

## 1.2. Моделирование абсолютной дифракционной эффективности

Для анализа дифракционных свойств изготавливаемых ВМРМБ с АСМ-измеренными профилями границ мы использовали хорошо зарекомендовавшие себя ранее модифицированный метод граничных интегральных уравнений [18] и компьютерную программу PCGrate<sup>TM</sup> [19]. Задача дифракции электромагнитного излучения на рельефе решетки сводится к решению векторного уравнения Гельмгольца со строгими граничными условиями и условиями излучения. Для решения данной задачи мы используем универсальный и высокоточный метод граничных интегральных уравнений, который был модифицирован для работы в коротковолновом диапазоне и обобщен на случай случайно-шероховатых поверхностей. В результате задача 3D-дифракции плоской волны на решетке общего вида, представляемой как бесконечная однопериодическая структура, сводится к системе уравнений Гельмгольца для одной из компонент электрического и магнитного полей в  $\mathbb{R}^2$ , для которой решения являются квазипериодическими в одном направлении, удовлетворяют условию излучения по отношению к другому направлению и испытывают скачки на интерфейсах между слоями решетки. Для конической дифракции, в отличие от классической, граничные величины выделенных компонент поля, также как их нормальные и тангенциальные производные, связаны. Метод оперирует только с граничными данными, из которых находится как ближнее, так и дальнее поле.

Оказалось, что модифицированный интегральный метод (МИМ) позволяет легко решать сложные дифракционные задачи на отражение и прохождение не только в одномодовом режиме (один интенсивный дифракционный порядок) и при углах, близких или меньших угла полного внешнего отражения (отсчитываемого от поверхности решетки) для данного материала, но и при огромном числе порядков, произвольной геометрии/ поляризации падающего излучения и любых параметрах решетки. То есть речь идет о таких входных параметрах дифракционной задачи, когда не работают не только все известные приближенные или асимптотические методы расчета абсолютной дифракционной эффективности решеток и интенсивности диффузного рассеяния, но и большинство строгих методов. Использование МИМ вместе со стохастическим анализом на основе метода Монте-Карло [20] позволяет нам моделировать не только η решеток с реалистическими параметрами, но и определять интенсивность рассеянного света и величину поглощенной энергии. Кроме того, разработанный и широко используемый нами метод граничных интегральных уравнений позволяет за счет быстрой сходимости применить его к намного более сложной дифракционной задаче — задаче синтеза (оптимизационной), что уже было апробировано на примере различных типов решеток, в том числе предназначенных для использования в космической аппаратуре и на концевых станциях РЛСЭ [17,21]. В настоящей работе аналогичный подход будет развит для определения дизайна и анализа *п* ВМРМБ. Применение современных компьютеров (рабочих станций, имеющих многониточные центральные процессоры и высокопроизводительные графические карты) и алгоритмов с возможностью оптимизации кодов и распараллеливания позволяет увеличить на несколько порядков скорость соответствующего моделирования, что также говорит о перспективности использования данного подхода для

решения тяжелых обратных задач рассеяния [22]. Универсальность и точность PCGrate<sup>TM</sup> позволяют решать практически любые задачи рассеяния на периодических, квазипериодических и случайных нанорельефах, хотя иногда это требует использования значительных вычислительных ресурсов [17]. Таким образом, использование в настоящей работе вышеописанных теоретических методов анализа и синтеза позволяет не только значительно удешевить затратные эксперименты по изготовлению высококачественные ВМРМБ с заданным профилем штрихов (границ), но и во многом заменить и/или дополнить трудоемкие измерения абсолютной дифракционной эффективности, обычно проводимые на источниках СИ.

Для анализа границ изготовленных ВМРМБ со случайной шероховатостью было применено статистическое усреднение интенсивности рассеяния излучения по методу Монте-Карло. При решении задачи рассеяния на решетке в качестве входных данных мы использовали реалистичные параметры слоев решетки (форма профиля границ, их шероховатость, плотность материала, диффузность интерфейсов). В результате в расчетах абсолютной дифракционной эффективности порядков решетки учитывалась не только усредненная форма (полигональная — полученная из микроскопических измерений или путем моделирования процесса роста) границ ее слоев, но и случайная шероховатость интерфейсов, приводящая к уменьшению  $\eta$  за счет интенсивности диффузного рассеяния. Приближения использовались только на этапе численного решения (обрезания бесконечных рядов/матриц и оценки сходимости процесса). Следует отметить, что при определении интенсивности рассеяния излучения на случайных и случайнопериодических рельефах требуется контролировать сходимость и точность процедуры не только по числу точек дискретизации (коллокации), но и по числу случайных реализаций (наборов случайных границ) в методе Монте-Карло.

## 1.3. АСМ-измерение реалистичных профилей штрихов

Для обеспечения воспроизводимости и возможности сравнения между собой результатов моделирования абсолютной дифракционной эффективности различных решеток мы разработали и опробовали методики измерений реалистичных профилей (усредненного профиля одного штриха и случайных профилей длиной несколько периодов) и шероховатости (высокочастотной и среднечастотной), используемых для расчета  $\eta$  решеток в программе PCGrate<sup>TM</sup>. Для моделирования  $\eta$  без учета случайной шероховатости мы используем усредненный профиль одного штриха решетки (рис. 1, *a*), который с высоким разрешением (> 500 точек) экспортируется в компьютерную программу PCGrate<sup>TM</sup>.

Для моделирования  $\eta$  со строгим учетом высокочастотной и среднечастотной составляющих шероховатости при любой статистике неровностей (по методу



**Рис. 1.** АСМ измеренные профили штрихов решетки Sv-4-3: *а* — усредненный профиль одного штриха; *b* — случайный профиль длиной три периода.

Решетка	Глубина штриха, nm	Длина отражающей грани, nm	Угол блеска, °	Толщина Мо/Ве покрытия, nm	Шероховатость, <i>Rms</i> , nm	
					$(1 \times 1 \mu m^2)$	$(20\mu m)$
Sv-4-1 Sv-4-3	11.0 11.0	345 356	1.8 1.8	230 230	0.45 0.39	0.69 0.70

Таблица 1. Параметры изготовленных решеток

Монте-Карло) мы используем случайные (не усредненные) профили штрихов длиной три периода (рис. 1, *b*), измеренные в различных областях по апертуре решетки. Следует отметить, что в подобные сканы входит как высокочастотная составляющая случайной шероховатости, так и среднечастотная, т.е. случайная форма профиля штрихов для решеток с малым периодом. В усредненных профилях одного штриха эти составляющие усредняются и профиль "сглаживается" и "выравнивается", т.е. форма профиля становится ближе к идеальной. Более подробно эти методики описаны в [23]. Подобные измерения должны проводиться как до, так и после нанесения многослойного покрытия.

По описанной выше методике для характеризации исследуемых ВМРМБ были измерены профили и шероховатость в нескольких областях на атомно-силовом микроскопе NT-MDT NTegra Aura. Во всех сканах было  $512 \times 512$  точек, и использовался полуконтактный метод сканирования. На рис. 1 приведены ACM профили решетки Sv-4-3, используемые для моделирования абсолютной дифракционной эффективности и интенсивности рассеянного излучения.

#### 1.4. Измерение абсолютной дифракционной эффективности

Параметры изготовленных решеток приведены в табл. 1. Исходя из полученных параметров и

данных расчета  $\eta$  (табл. 2), измерения дифракционной эффективности лучшей (Sv-4-3)решетки были выполнены на высокоразрешающем спектрометре Черни-Тёрнера с плоской дифракционной решеткой и двумя сферическими коллимирующими зеркалами В качестве монохроматора и лазерно-плазменным источником излучения [24]. Абсолютная дифракционная эффективность измерялась в различных порядках дифракции по методике, использовавшейся лля исследования аналогичной среднечастотной ( $d \approx 2 \, \mu m$ ) многослойной Mo/Si-решетки с блеском, на которой нами была получена рекордная  $\eta \sim 40\%$  в -8 порядке на  $\lambda = 13.5 \,\text{nm}$  неполяризованного излучения [25]. При измерениях на  $\lambda = 11.3$  nm угол падения излучения был близок к нормали к плоскости решетки и составлял  $3^{\circ} - 8^{\circ}$ .

# 2. Результаты и обсуждение

Теоретически (моделированием) и экспериментально (измерениями) мы определяли  $\eta$  решеток Sv-4-1 и Sv-4-3 для неполяризованного излучения с длиной волны  $\lambda = 11.3$  nm в классической схеме измерений (в плоскости дисперсии). На рис. 2 для сравнения приведены смоделированные на основе идеального треугольного профиля границ с  $\alpha = 1.8^{\circ}$  и углом антиблеска  $\beta = 25^{\circ}$  кривые дифракционной эффективности первых порядков

	$\eta(-2),\%$						
Решетка	Расчет для идеальной решетки	Расчет без учета шероховатости	Расчет с учетом шероховатости	Измерение			
Sv-4-1 Sv-4-3	66.0	53.7 59.7	29.0	38.0			

**Таблица 2.** Абсолютная дифракционная эффективность ( $\eta$ ) решеток



**Рис. 2.** Абсолютная дифракционная эффективность порядков идеальной 40-бислойной Мо/Ве многослойной решетки с  $\Lambda = 5.7$  nm и треугольной формой границ с  $\alpha = 1.8^{\circ}$  и  $\beta = 25^{\circ}$ для  $\lambda = 11.3$  nm в зависимости от угла падения.

идеальной 40-бислойной Мо/Ве-решетки с периодом многослойного покрытия  $\Lambda = 5.7$  nm в диапазоне углов падения  $\theta$  от 0.5° до 9.5°. Как следует из приведенных графиков  $\eta(-2) \approx 66\%$ , а эффективность соседних порядков на несколько порядков меньше.

На рис. З показаны смоделированные на основе усредненного профиля одного штриха (без учета шероховатости отражающей грани) графики абсолютной дифракционной эффективности порядков от 0 до -3 решетки Sv-4-3 для  $\lambda = 11.3$  nm и  $\theta$  в диапазоне  $0.5^{\circ}-9^{\circ}$ . Как видно из приведенных на рис. З графиков,  $\eta(-2) \approx 60\%$ , т.е. всего на 10% меньше, чем у идеальной решетки. При этом, эффективность соседних порядков в десятки раз меньше, включая нулевой порядок. Максимальная теоретическая  $\eta$  решетки Sv-4-1, определенная с помощью усредненного профиля штриха, оказалась на 6% меньше (табл. 2).

Абсолютная дифракционная эффективность в -2-м порядке, рассчитанная на основе АСМ измеренных в нескольких областях решетки Sv-4-3 случайных профилей (с учетом случайной шероховатости), составила на  $\lambda = 11.3$  nm  $\sim 29\%$  (рис. 4), т.е. в два раза меньше, по сравнению с  $\eta$ , рассчитанной для усредненного профиля штрихов без учета случайной шероховатости — как



**Рис. 3.** Абсолютная дифракционная эффективность порядков решетки Sv-4-3 (Мо/Ве) при  $\lambda = 11.3$  nm в зависимости от угла падения (без учета шероховатости).

высокочастотной, так и среднечастотной, т.е. с учетом случайной формы профиля штриха. Следует отметить, что подобная величина  $\eta$  может существенно зависеть от случайного выбора областей решетки (в центре, на краях).

При измерениях решетки Sv-4-3 максимум абсолютной дифракционной эффективности ~ 38% в –2 порядке детектировался на длине волны 11.3 nm в классической оптической схеме при угле падения  $\theta = 3^{\circ}$  и угле детектора 177° (рис. 5), что с точностью  $0.1^{\circ}-0.2^{\circ}$  соответствует теоретическому углу дифракции  $\theta(-2) = -0.2^{\circ}$ . Дифракционная эффективность, измеренная в –2 порядке при больших углах падения, плавно уменьшается с увеличением угла падения и составляет ~ 30% при  $\theta = 8^{\circ}$  (рис. 5), что хорошо согласуется с теоретическими значениями.

Для исследования однородности измеряемой дифракционной эффективности была оценена отражательная способность при перемещении решетки Sv-4-3 с помощью подвижки по координате, перпендикулярной штрихам (насколько позволяет используемая подвижка), и фиксированном угле падения  $\theta = 5^{\circ}$ . На рис. 6 приведен график  $\eta(-2)$ , измеренной на длине волны неполяризованного излучения  $\lambda = 11.3$  nm в классической схеме в зависимости от координаты столика при сканировании



**Рис. 4.** Абсолютная дифракционная эффективность порядков (номера умножены на три) и поглощение решетки Sv-4-3 (Mo/Be) при  $\lambda = 11.3$  nm в зависимости от угла падения (с учетом шероховатости).



**Рис. 5.** Абсолютная эффективность -2 порядка решетки Sv-4-3, измеренная в неполяризованном излучении с  $\lambda = 11.3$  nm в классической схеме при  $\theta = 3^{\circ} - 8^{\circ}$ , от угла сканирования детектора.

решетки Sv-4-3. На рис. 6 видно, что при сканировании решетки на длине 11 mm (координата столика изменяется от 189 до 200 mm)  $\eta(-2)$  изменяется от 0.28 до 0.36. Таким образом, неоднородность значений абсолютной дифракционной эффективности, вычисленная как отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению, составляет ±8.3%.

В табл. 2 приведены максимальные значения  $\eta$  исследуемых решеток, полученные: 1) моделированием в программе PCGrate<sup>TM</sup> для идеальной решетки с аналогичными параметрами; 2) моделированием в программе PCGrate<sup>TM</sup> для изготовленной решетки без учета случайной шероховатости поверхности отражающей грани;

Журнал технической физики, 2024, том 94, вып. 7

3) моделированием в программе PCGrate<sup>TM</sup> для изготовленной решетки с учетом случайной шероховатости поверхности отражающей грани; 4) измерениями изготовленной решетки с помощью рефлектометра на длине волны 11.3 nm. Из табл. 2 видно, что для решетки Sv-4-1 расчетное значение  $\eta$  на 6.0% меньше, чем для решетки Sv-4-3, что можно объяснить меньшей длиной отражающей грани. Максимальный коэффициент отражения для выбранного многослойного покрытия при N = 40 составляет R = 0.72; следовательно, относительная дифракционная эффективность идеальной решетки составляет 91.7%, а максимальная относительная дифракционная эффективность решетки Sv-4-3 по результатам моделирования с реалистичным профилем, но без учета случайной шероховатости, составила 82.9%, что всего на 8.8% меньше теоретически достижимого расчетного значения. Это означает, что средний профиль решетки Sv-4-3 близок к идеальному треугольному несимметричному.

Максимальный коэффициент отражения нанесенного Мо/Ве-покрытия по измерениям свидетеля составил  $\sim$  0.60; таким образом, максимальная относительная эффективность решетки Sv-4-3 по результатам измерений составила 63.3%, что на 19.6% меньше теоретического значения с учетом АСМ измеренного усредненного профиля штрихов. Такое отклонение измеренной эффективности от моделированного значения для реалистичного профиля вызвано несколькими причинами: 1) неточностью согласования профиля штриха решетки и периода многослойного покрытия; 2) рассеянием излучения на неровностях поверхности (случайной шероховатости); (3) отсутствием рисунка (отражающих граней) на 5-7% площади решетки из-за ститчинга при записи электронно-литографической маски [13]; 4) изогнутостью отражающей грани из-за не полностью удаленных Si-выступов (работает не вся длина отражающей



**Рис. 6.** Зависимость абсолютной эффективности -2 порядка решетки Sv-4-3, измеренная в неполяризованном излучении с  $\lambda = 11.3$  nm в классической схеме при  $\theta = 5^{\circ}$ , в зависимости от координаты столика при перемещении решетки.

грани) [26]; 5) неоднородностью штрихов по апертуре решетки.

## Заключение

Были выполнены теоретико-экспериментальные исследования дифракционной эффективности высокочастотных многослойных Мо/Ве-решеток с  $d \sim 400 \,\mathrm{nm}$ и малым углом блеска ~ 1.7°. Моделирование проводилось с помощью созданной на основе строгого метода граничных интегральных уравнений компьютерной программы PCGrate<sup>TM</sup> и усредненных и случайношероховатых профилей штрихов, полученных из данных АСМ. Данные расчетов верифицировались путем прямых измерений в ЭУФ диапазоне, выполненных на лабораторном оборудовании с использованием рефлектометра с высокоразрешающим спектрометром Черни-Тёрнера. Дифракционные решетки с блеском были изготовлены на пластинах Si(111)1.8° с применением методов электронно-лучевой литографии и жидкостного анизотропного травления. После нанесения методом магнетронного напыления 40 периодов Мо/Ве-покрытия общей толщиной ~ 230 nm решетки имели близкий к идеальному треугольный несимметричный профиль штрихов с приемлемым значением шероховатости поверхности отражающих граней, о чем свидетельствуют результаты моделирования эффективности и измерений профилей на атомно-силовом микроскопе.

Измеренная абсолютная дифракционная эффективность решетки Sv-4-3 составила  $\sim 38\%$  в -2 порядке на длине волны 11.3 nm в классической оптической схеме дифракции при угле падения 3°, отсчитываемого относительно нормали к поверхности решетки. Максимальная относительная эффективность решетки составила  $\sim 63\%$ , что на 30% меньше теоретически достижимой, полученной для идеального треугольного профиля штрихов. Как следует из проведенного анализа, уменьшение эффективности связано, в первую очередь, с наличием случайной шероховатости, а также дефектностью маски (ститчингом) при изготовлении кремниевой решетки.

Наши дальнейшие усилия будут направлены на оптимизацию режимов записи электронно-лучевой маски с целью устранения ститчинга, а также улучшения профиля штрихов (уменьшения случайной шероховатости) и однородности параметров решетки по площади. Это позволит заметно увеличить относительную дифракционную эффективность высокочастотных многослойных решеток с малым углом блеска и приблизить ее к теоретическому пределу. Если к этому добавить совершенствование процесса нанесения многослойных покрытий для увеличения отражательной способности, то вместе это позволит достичь рекордных значений абсолютной дифракционной эффективности ВМРМБ столь необходимых для различных приложений в ЭУФ и MP, а также и в жестком рентгеновском излучении.

### Благодарности

Авторы благодарны АО "Светлана-Электронприбор" за проведение научно-исследовательской работы.

#### Финансирование работы

Работа Л.И. Горая, А.С. Дашкова, Н.А. Костромина и А.Д. Буравлева выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в части экспериментальных исследований (№ 075-01438-22-06, FSEE-2022-0018). В плане теоретических исследований, работа Л.И. Горая, А.С. Дашкова и Н.А. Костромина выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 23-29-00216).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- L. Goray, W. Jark, D. Eichert. J. Synchrotron Rad, 25 (6), 1683 (2018). DOI: 10.1107/S1600577518012419
- D.L. Voronov, L.I. Goray, T. Warwick, V.V. Yashchuk, H.A. Padmore. Opt. Express, 23 (4), 4771 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.004771
- [3] D.L. Voronov, E.M. Gullikson, F. Salmassi, T. Warwick, H.A. Padmore. Opt. Lett., 39 (11), 3157 (2014). DOI: 10.1364/OL.39.003157
- [4] D.L. Voronov, F. Salmassi, J. Meyer-Ilse, E.M. Gullikson, T. Warwick, H.A. Padmore. Opt. Express, 24 (11), 11334 (2016). DOI: 10.1364/OE.24.011334
- [5] A. Sokolov, Q. Huang, F. Senf, J. Feng, S. Lemke, S. Alimov, J. Knedel, T. Zeschke, O. Kutz, T. Seliger, G. Gwalt, F. Schäfers, F. Siewert, I. Kozhevnikov, R. Qi, Z. Zhang, W. Li, Z. Wang. Opt. Express, 27 (12), 16833 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.016833
- [6] N.I. Chkhalo, N.N. Salashchenko. AIP Advances, 3 (8), 082130 (2013). DOI: 10.1063/1.4820354
- [7] M.V. Svechnikov, N.I. Chkhalo, S.A. Gusev, A.N. Nechay, D.E. Pariev, A.E. Pestov, V.N. Polkovnikov, D.A. Tatarskiy, N.N. Salashchenko, F. Schäfers, M.G. Sertsu, A. Sokolov, Y.A. Vainer, M.V. Zorina. Opt. Express, 26 (26), 33718 (2018). DOI: 10.1364/OE.26.033718
- [8] N.I. Chkhalo, S.A. Garakhin, A.Ya. Lopatin, A.N. Nechay, A.E. Pestov, V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, N.N. Tsybin, S.Yu. Zuev. AIP Advances, 8 (10), 105003 (2018). DOI: 10.1063/1.5048288
- [9] V.N. Polkovnikov, N.I. Chkhalo, R.S. Pleshkov, N.N. Salashchenko, F. Schäfers, M.G. Sertsu, A. Sokolov, M.V. Svechnikov, S.Yu. Zuev. Opt. Lett., 44 (2), 263 (2019). DOI: 10.1364/OL.44.000263
- [10] Л.И. Горай, Т.Н. Березовская, Д.В. Мохов, К.Ю. Шубина, Е.В. Пирогов, В.А. Шаров, А.С. Дашков, Н.А. Костромин, М.В. Зорина, М.М. Барышева, С.А. Гарахин, С.Ю. Зуев, К.В. Николаев, С.Н. Якунин, Б.С. Рощин, Н.И. Чхало, В.Е. Асадчиков, А.Д. Буравлев. Сборник тез. конф. "Электронно-лучевые технологии и рентгеновская оптика в микроэлектронике" КЭЛТ-23 (Черноголовка, Россия, 2023), с. 219.

- [11] Д.В. Мохов, Т.Н. Березовская, К.Ю. Шубина, Е.В. Пирогов, А.В. Нащекин, В.А. Шаров, Л.И. Горай. ЖТФ, 92 (8), 1192 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.08.52782.74-22 [D.V. Mokhov, T.N. Berezovskaya, K.Yu. Shubina, E.V. Pirogov, A.V. Nashchekin, V.A. Sharov, L.I. Goray. Tech. Phys., 92 (8), 1009 (2022).
  - DOI: 10.21883/TP.2022.08.54564.74-22]
- [12] Электронный ресурс. Режим доступа: https://henke.lbl.gov/optical\_constants/
- [13] Д.В. Мохов, Т.Н. Березовская, Е.В. Пирогов, К.Ю. Шубина, Н.Д. Прасолов, М.В. Зорина, С.А. Гарахин, Р.С. Плешков, Н.И. Чхало, А.С. Дашков, Н.А. Костромин, Л.И. Горай, А.Д. Буравлев. ЖТФ, 94 (7), (2024).
- [14] Ф.М. Герасимов, Э.А. Яковлев. Современные тенденции в технике спектроскопии сб. статей, ред. С.Г. Раутиан (Новосибирск, Наука, 1982), с. 24–93. [F.M. Gerasimov, E.A. Yakovlev. Current Trends in Spectroscopy Technology, ed. by S.G. Rautian (Nauka, Novosibirsk, 1982, in Russian)]
- [15] E.G. Loewen, E. Popov. *Diffraction Gratings and Applications* (CRC Press, 2018), 630 p.
- [16] Л.И. Горай. Известия РАН. Сер. физическая, 69 (2), 211 (2005).
   [L.I. Gorai. Bull. Russian Academy Sciences. Physics, 69 (2), 231 (2005).]
- [17] L. Goray. J. Synchrotron Rad., 28 (1), 196 (2021).
   DOI: 10.1107/S160057752001440X
- [18] L.I. Goray, G. Schmidt. Gratings: Theory and Numerical Applications (Presses Universitaires de Provence, Marcel, 2014), Ch. 12.
- [19] Л.И. Горай, С.Ю. Садов. Компьютерная программа PCGrate<sup>TM</sup>. URL: www.pcgrate.com
- [20] D.P. Kroese, T. Taimre, Z.I. Botev. Handbook of Monte Carlo Methods (Wiley, 2011), 772 p.
- [21] H. Marlowe, R.L. McEntaffer, C.T. Deroo, D.M. Miles, J.H. Tutt, L.I. Goray, F. Scholze, A.F. Herrero, C. Laubis, V. Soltwisch. Appl. Opt., 55 (21), 5548 (2016).
- [22] L.I. Goray, A.S. Dashkov, N.A. Kostromin, D.A. Barykin, 2023 Days on Diffraction (DD), Proc. IEEE, 101 (2023). DOI: 10.1109/DD58728.2023.10325796.
- [23] Л.И. Горай, В.А. Шаров, Д.В. Мохов, Т.Н. Березовская, Шубина, A.C. К.Ю. E.B. Пирогов, Дашков, А.Д. Буравлев. ЖТФ, 93 (7), 859 (2023).10.21883/JTF.2023.07.55738.66-23 DOI: L.I. Goray. V.A. Sharov, D.V. Mokhov, T.N. Berezovskaya, K.Yu. Shubina, E.V. Pirogov, A.S. Dashkov, A.D. Bouravleuv. Tech. Phys., **68** (7), 797 (2023). DOI: 10.61011/TP.2023.07.56619.66-23
- [24] S.A. Garakhin, N.I. Chkhalo, I.A. Kas'kov, A.Ya. Lopatin, I.V. Malyshev, A.N. Nechay, A.E. Pestov, V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, M.V. Svechnikov, N.N. Tsybin, I.G. Zabrodin, S.Yu. Zuev. Rev. Sci. Instrum., **91** (6), 063103 (2020). DOI: 10.1063/1.5144489
- [25] Л.И. Горай, Т.Н. Березовская, Д.В. Мохов, В.А. Шаров, К.Ю. Шубина, Е.В. Пирогов, А.С. Дашков, А.В. Нащекин, М.В. Зорина, М.М. Барышева, С.А. Гарахин, С.Ю. Зуев, Н.И. Чхало. Квантовая электроника, **52** (10), 955 (2022). https://www.mathnet.ru/rus/qe18114
  [L.I. Goray, T.N. Berezovskaya, D.V. Mokhov, V.A. Sharov, K.Yu. Shubina, E.V. Pirogov, A.S. Dashkov, A.V. Nashchekin, M.V. Zorina, M.M. Barysheva, S.A. Garakhin, S.Yu. Zuev, N.I. Chkhalo. Bull. Lebedev Phys. Inst., **50** (2), S250 (2023). DOI: 10.3103/S1068335623140063]
- [26] L.I. Goray, T.N. Berezovskaya, D.V. Mokhov, V.A. Sharov, K.Yu. Shubina, E.V. Pirogov, A.S. Dashkov. J. Surf. Invest., 17 (1), S104 (2023). DOI: 10.1134/S1027451023070145